

SM-4-0

β_i ($M(OH)_3$) ($_{cp}$) $M = La, Ce, Pr, Nd, Pm, \text{ и др.}$
 β_{eu} , $g_{d}, Tb, Dy: Ho, Er, Tm, Lu$
($M(OH)$) ($M = Ce, Y, La, Nd, Pm, \underline{Sm}, Eu$
 $v_{III} 292$ $g_d, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu$

Киевцов Н. В., Киевчова Р. Г.,
Шеина Л. Н. // Ж. спиркулурн.
хими, 1987, 8, № 2, 268 - 72

px 1967

10

$\text{Sm}(\text{OH})_3$

1980

Ryskin Ye. L. et al.

бкн: Kolebaniya Okisnykh
korev. Reshetok 1980, 198-227.
енекмп.,

$\text{I}(\text{O-H})$

л.: Наука, 1980



(ав. LiOH ; II)

SmH₂

1988

5 Б2249. Электронная структура SmH₂. Electronic structure of SmH₂ / Sen Gupta R., Chatterjee S. // Phys. status solidi. B.— 1988.— 148, № 2.— С. 579—584.— Англ.; рез. нем.

Методом присоединенных плоских волн изучено электронное строение SmH₂ (I). Рассчитаны законы дисперсии электронов вдоль высокосимм. направлений зоны Бриллюэна, энергетич. зависимость плотности состояний, мнимая часть диэл. ф-ции и сечения Пв Ферми вдоль плоскостей $\Gamma L X$ и $\Gamma L K$. Установлено, что электронное строение I характеризуется присутствием под d-уровнями металла двух зон состояний Sm—Н, определяющих стабильность решетки. Уровень Ферми пересекает вырожденные зоны, что определяет металлич. св-ва I. Полученные данные использованы для интерпретации эл. и оптич. св-в кристалла. П. Н. Дьячков

Электронные
строение

X. 1989, N 5